









	<h2 style="color: red;">IPI80N06S2L11AKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI80N06S2L11AKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  IPI80N06S2L11AKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI80N06S2L11AKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 93µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 60A, 10V
Verlustleistung (max)	158W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2075pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPI80N06S2L11AKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI80N06S2L11AKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI80N06S2L11AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI80N06S2L11AKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI80N06S2L05AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI80N06S207AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI80N06S3-05 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-262</p>	 <p>IPI80N06S3L-05 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-262</p>
 <p>IPI80N06S3L-08 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-262</p>	 <p>IPI80N06S2L11AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI80N06S208AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI80N06S208AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI80N06S2L11AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI80N06S2L11AKSA1 Datenblatt	IPI80N06S2L11AKSA1-Datenblätter	IPI80N06S2L11AKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI80N06S2L11AKSA1
IPI80N06S2L11AKSA1 Electronic	IPI80N06S2L11AKSA1-Komponenten	IPI80N06S2L11AKSA1-Verteiler	IPI80N06S2L11AKSA1-Bild	IPI80N06S2L11AKSA1-Teil
IPI80N06S2L11AKSA1 Preis	IPI80N06S2L11AKSA1 Hersteller	IPI80N06S2L11AKSA1 Bild	IPI80N06S2L11AKSA1 Aktie	IPI80N06S2L11AKSA1 Inventar
IPI80N06S2L11AKSA1 Neu	IPI80N06S2L11AKSA1 Original	IPI80N06S2L11AKSA1 garantiert	IPI80N06S2L11AKSA1 RFQ	IPI80N06S2L11AKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited